

研究設備センター運営委員会資料2
平成24年5月10日

教育研究設備整備計画表					
(単位:千円)					
年度別設備名	区分	新規/更新等	特別経費	法人内経費	化学系研究設備有効活用ネットワークへの参加による経費
			基盤的設備等整備枠による整備	自助努力による整備	
平成25年度			164,000	45,000	9,345
電子ビーム露光装置	基盤的大型	更新	97,000		
電子線元素状態分析装置	基盤的大型	更新	67,000		
拡散酸化炉	基盤的設備	更新		15,000	
半導体プロセス設備	基盤的大型	更新		30,000	
蛍光寿命測定装置	基盤的設備	復活再生			9,345
平成26年度			147,000	50,000	0
有機金属気相成長(MOCVD)装置	基盤的大型	更新	147,000		
超微細放電加工機	基盤的設備	更新		20,000	
半導体測定器	基盤的大型	更新		30,000	
平成27年度			120,000	41,500	0
エレクトロニクス素子と集積の総合的理解を目指す教育設備	共通的设备	更新	40,000		
高分解能走査型電子顕微鏡	基盤的大型	更新	80,000		
基礎科学実験分光分析システム	共通的设备	更新		11,500	
走査型プローブ顕微鏡	基盤的大型	更新		30,000	
小計			431,000	136,500	9,345
平成28年度以降			594,876,601	118,844,700	0
イオン注入装置 外 7点	基盤的大型	更新	594,876,601		
DSC粉末X線同時測定装置 外 6点	基盤的設備	更新		118,844,700	
合計			595,307,601	118,981,200	9,345

(注)区分について

- ・基盤的大型：3,000万円以上の共同利用の大型設備
- ・基盤的設備：1,000万円～3,000万円未満の共同利用設備
- ・共通的设备：学科、専攻等の共通教育研究設備(教育水準維持のための基礎実験・実習設備)
- ・先端的大型：特色ある研究に必要な先端的大型設備

b DSC粉末X線同時測定装置	24,192,000
1 オプトメカトロニクスデバイス評価システム	30,000,000
2 ESI - TOF型質量分析装置	12,799,500
3 高速応答FT-IR	9,799,650
4 顕微レーザーラマン分光計	14,994,000
5 動き解析・蛍光カラー顕微観察システム	16,874,550
6 高性能膜厚解析装置	10,185,000
	118,844,700

c 走査型プローブ顕微鏡	46,200,000
1 イオン注入装置	62,830,000
2 三次元レーザー干渉計測装置	30,817,600
3 高密度プラズマエッチング装置	56,878,500
4 超伝導フーリエ変換NMR (500MHz)	69,750,001
5 ヘリウム液化システム	204,700,000
6 超伝導量子干渉型磁束計	39,847,500
7 X線光電子分析装置	83,853,000
	594,876,601

教育研究設備整備計画表

(単位:千円)

年度別設備名	区分	新規/ 更新等	特別経費	法人内経費	化学系研究設備有効活用ネットワークへの参加による経費
			基盤的設備等整備 枠による整備	自助努力による整備	
平成23年度			206,200	31,000	23,273
高磁場多目的物性測定システム	基盤的大型	更新	56,200		
電子スピン共鳴装置	基盤的大型	更新	50,000		
電子ビーム露光装置	基盤的大型	更新	100,000		
人工衛星追尾受信システム	共通的设备	更新		11,000	
ウェットステーション	基盤的设备	更新		20,000	
元素分析装置	基盤的设备	復活再生			10,000
蛍光寿命量子収率計測システム	基盤的设备	復活再生			13,273
平成24年度			110,860	0	0
電子線元素状態分析装置	基盤的大型	更新	70,000		
結晶方位分散分析走査電子顕微鏡	基盤的大型	更新	40,860		
拡散酸化炉	基盤的设备	更新		20,000	
平成25年度			150,000	30,000	0
有機金属気相成長(MOCVD)装置	基盤的大型	更新	150,000		
半導体測定器	基盤的大型	更新		30,000	
平成26年度			70,392	30,000	0
結晶材料構造評価システム	基盤的大型	更新	70,392		
半導体プロセス評価	基盤的大型	更新		30,000	
平成27年度			112,000	40,000	0
200kV電界放出型透過型電子顕微鏡	基盤的大型	更新	112,000		
オプトメカトロニクスデバイス評価システム	基盤的大型	更新		40,000	
小計			649,452	131,000	23,273
平成28年度以降			1,000,000	244,500	0
イオン注入装置外8点	基盤的大型	更新	1,000,000		
エレクトロニクス素子と集積の総合的理解を目指す教育設備	共通的设备	更新		44,500	
高密度プラズマエッチング装置外4点	先端的大型	更新		200,000	
合計			1,649,452	375,500	23,273

(注)区分について

- ・基盤的大型：3,000万円以上の共同利用の大型設備
- ・基盤的设备：1,000万円～3,000万円未満の共同利用設備
- ・共通的设备：学科、専攻等の共通教育研究設備(教育水準維持のための基礎実験・実習設備)
- ・先端的大型：特色ある研究に必要な先端的大型設備